PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-120689

(43) Date of publication of application: 12.05.1998

(51)Int.CI.

CO7F 7/08 B01J 31/02

// CO7B 61/00

(21)Application number: 08-274561

(71)Applicant: MITSUI CHEM INC

(22)Date of filing:

17.10.1996

(72)Inventor: ISHIKAWA JUNICHI

INOUE KOJI IWATA KENJI FUJIKAKE SHIRO ITO MASAYOSHI

(54) PRODUCTION OF SILICON-BASED COMPOUND AND SILICON-BASED POLYMER (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simply produce a silicon-based compound and a silicon-based polymer comprising industrially useful silylacetylenes in high yield by reacting a specific silyl compound with an ethynyl compound in the presence of a metallic hydride compound catalyst.

SOLUTION: A silyl compound represented by formula I [(m) is a positive integer of ≤3; R is a 1-30C alkyl. alkenyl, alkynyl, a (substituted)phenyl or a (substituted) naphthyl] (e.g. phenylsilane) is reacted with an ethynyl compound represented by formula II [R1 is H, a 1-30C alkyl, alkenyl, alkynyl, a (substituted)phenyl or a (substituted)naphthyl] (e.g. phenylacetylene) in the presence of a metallic hydride (e.g. LiAlH4) to afford the objective silicon-based compound composed of industrially useful silvlacetylenes represented by formula III [(i) is a positive integer not larger than (m)].



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of xtinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公問番号

特開平10-120689

(43)公開日 平成10年(1998)5月12日

(51) Int.Cl. ⁴ C 0 7 F 7/08 B 0 1 J 31/02 # C 0 7 B 61/00	2	FI C07F 7/08 B01J 31/02 C07B 61/00 300
		審査開求 未贈求 請求項の数4 OL (全 16 頁)
(21)出顯番号	特願平8-274561	(71)出腹人 000003126 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区腹が関三丁目 2 番 5 号
(22) 出顧日	平成8年(1996)10月17日	(72)発明者 石川 淳一 神奈川県横浜市条区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内
		(72)発明者 井上 浩二 神奈川県横浜市榮区笠間町1190番地 三 東圧化学株式会社内
		(72)発明者 岩田 健二 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三夫 東圧化学株式会社内
		最終頁に統

(54) 【発明の名称】 ケイ索系化合物およびケイ索系ポリマーの製造方法

(57)【要約】

【課題】 ケイ素系化合物およびケイ素系ポリマーの製造方法を提供する。

【解決手段】 シリル化合物とアセチレン化合物より金属水素化物を触媒として一般式(1)

$$(R^{1}-C\equiv C) = Si-H_{in-i} \qquad (1)$$

で表されるシリルアセチレン化合物および一般式(4)

$$-C \equiv C - \left(R^4\right)_{\stackrel{\frown}{n}} C \equiv C - \begin{cases} R^2 \\ \vdots \\ R^3 \end{cases}$$
 (4)

で表される繰り返し単位を有するケイ素系ポリマーを製 造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 R....-SiH.(式中、mは3以下の正の整数であり、Rは炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルナニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。mが1または2であるときRは各々が同じでも異なっていてもよい。)で表されるシリル化合物とR¹ーC≡CH(式中、R¹は水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。)で表されるエチニル化合物を金属水素化物の存在下に反応させることを特徴とする一般式(1)(化1)

【化1】

(式中、mは3以下の正の整数であり、Rは炭素数1か 20 630のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。mが1または2であるときRは各々が同じでも異なっていてもよい。R¹は水紫原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。iはm以下の正の整数である。)で表されるシリル 30 アセチレン化合物の製造方法。

【請求項2】 常圧で沸点が0℃以上である請求項1記載のシリル化合物およびエチニル化合物を用い、反応温度を反応圧力におけるシリル化合物とエチニル化合物の沸点以下とすることを特徴とする請求項1記載のシリルアセチレン化合物の製造方法。

【請求項3】 SiH、とR'-C=CH(式中、R'は 水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケ ニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの 芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カ 40 ルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいても よい。)で表されるエチニル化合物をピス(2-メトキ シエチル)エーテルおよび/または1、2-ピス(2-メトキシエトキシ)エタンを溶媒として金属水素化物の 存在下反応させることを特徴とする一般式(2)(化 2)

【化2】

$$(R^1-C\equiv C)$$
 SiH₄ (2)

(式中、R1 は水素原子または炭素数1から30のアル 50

キル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。 j は4以下の正の整数である。) で表されるシリルアセチレン類の製造方法。

【請求項4】 R²-SiH.-R³(式中、R²及びR³は互いに独立に、水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。)で表されるヒドロシリル化合物と一般式(3)(化3)

[143]

(式中、R*は炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレン基などの二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋 園により炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。nは0または4以下の正の整数である。)で表されるジエチニル化合物を金属水素化物の存在下に反応させることを特徴とする一般式(4)(化4)

$$-C \equiv C - \left(R^4\right)_{n} C \equiv C - Si - (4)$$

(式中、R*及びR*は互いに独立に、水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、R*は炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、方金族基が直接または架橋員により炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの圏換基を含んでいてもよい。nは0または4以下の正の整数である。)で表される繰り返し単位を含むアセチレン結合を有するケイ素系ポリマーの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シリル化合物とアセチレン化合物より金属水素化物を触媒として産業上有用なケイ繁系化合物およびケイ素系ポリマーを製造する新規な方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、シリル化合物とアセチレン化合物 よりアセチレン結合を有するケイ索系化合物またはケイ 紫系ポリマーを合成する方法としては、J. F. Harrodら の論文に記載されている塩化第一銅を触媒、アミン化合 物を助触媒とする方法(Hua Qin Liu and John F. Harr od, Canadian Journal of Chemistry, Vol. 68, 1100-1 105 (1990))、本発明者らが提案した塩基性金属酸化物 触媒を使用する方法 (例えば特開平5-345825. 特願平4-240593) が知られている。しかし、J. F. Harrodらの方法では助触媒であるアミン化合物の除 10 去が困難である。また塩基性金属酸化物触媒を使用する 方法では、金属水酸化物を高温で熱分解するなどの触媒 活性化の手間が必要であった。また、本発明者らはテト ラヒドロフランを溶媒としてLiAlH,触媒によりS i H, とエチニル化合物からシリルアセチレン類を合成 している(特開平3-181488)がその収率はあま り髙くなかった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、金属水素化物を触媒とすることによりシリル化合物とエチニル化合物よりアセチレン結合を有するケイ素系化合物が、またヒドロシリル化合物とジエチニル化合物よりケイ索系ポリマーが簡便に得られることを見いだした。また、SiH、とエチニル化合物より金属水素化物を合成する反応においてビス(2ーメトキシエチル)エーテルまたは1、2ービス(2ーメトキシエトキシ)エタンを溶媒とすることによりシリルアセチレン類の収率が向上することを見い出し、本発明に到達した。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、R...ーSiH。(式中、mは3以下の正の整数であり、Rは炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。mが1または2であるときRは各々が同じでも異なっていてもよい。)で表されるシリル化合物とR¹-C=CH(式中、R¹は水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの 40 芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。)で表されるエチニル化合物を金属水素化物の存在下に反応させることを特徴とする…般式(1)(化5)

-[0005]

【化5】

$$R_{-m}$$
 (R'-C=C) Si-H_{m-l} (1)

(式中、mは3以下の正の整数であり、Rは炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。mが1または2であるときRは各々が同じでも異なっていてもよい。R¹は水素原子または炭素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。iはm以下の正の整数である。)で表されるシリルアセチレン化合物の製造方法である。

【0006】また、本発明は常圧で沸点が0°C以上であ るR4-m-SiH。(式中、mは3以下の正の整数であ り、Rは炭素数 1 から 3 0 のアルキル基、アルケニル 基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香 族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキ シル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。 mが1または2であるときRは各々が同じでも異なって いてもよい。)で表されるシリル化合物およびR1-C ■CH (式中、R'は水素原子または炭素数1から30 のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル 基やナフチル基などの芳香族基であり、ハロゲン原子、 水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの 置換基を含んでいてもよい。)で表されるエチニル化合 物を用い、反応温度を反応圧力におけるシリル化合物と エチニル化合物の沸点以下とすることを特徴とする一般 式(1) (式中、mは3以下の正の整数であり、Rは炭 素数 1 から 3 0 のアルキル基、アルケニル基、アルキニ 30 ル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基でありハ ロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エー テル基などの置換基を含んでいてもよい。mが1または 2であるときRは各々が同じでも異なっていてもよい。 R¹は水素原子または炭素数1から30のアルキル基、 アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基 などの芳香族基でありハロゲン原子、水酸基、アミノ 基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んで いてもよい。iはm以下の正の整数である。)で表され るシリルアセチレン化合物の製造方法である。

【0007】また、本発明はSiH、とR¹-C≡CH(式中、R¹は水素原子または炭素数1か630のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。)で表されるエチニル化合物をピス(2-メトキシエチル)エーテルおよび/または1、2-ピス(2-メトキシエトキシ)エタンを溶媒として金属水素化物の存在下反応させることを特徴とする一般式(2)(化6)

50 [0008]

[116]

$$(R^1-C\equiv C)_i SiH_{4i}(2)$$

(式中、R'は水素原子または炭素数1から30のアル キル基、アルケニル基、アルキニル基、フェニル基やナ フチル基などの芳香族基であり、ハロゲン原子、水酸 基、アミノ基、カルボキシル基、エーテル基などの置換 基を含んでいてもよい。 j は4以下の正の整数であ る。)で表されるシリルアセチレン類の製造方法であ

【0009】また、本発明はR'-SiH₂-R'(式 中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭素数 1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニル 基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、こ れらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキ シル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。)で表されるヒドロシリル化合物と一般式(3) ((£7)

[0010]

[{t7]

$$HC \equiv C - \left(R^4\right)_C \equiv CH$$
 (3)

(式中、R*は炭素数1から30のアルキレン基、アル ケニレン基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレ ン基などの二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋 員により炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレ ン基、アルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、 これらの基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボ*

*キシル基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよ い。 nは0または4以下の正の整数である。) で表され るジエチニル化合物を金属水素化物の存在下に反応させ ることを特徴とする一般式(4)(化8)

[0011] [化8]

$$-C \equiv C - \left(R^4\right)_n C \equiv C - \begin{cases} R^2 \\ Si - C - Si$$

(式中、R'及びR'は互いに独立に、水素原子または炭 素数1から30のアルキル基、アルケニル基、アルキニ ル基、フェニル基やナフチル基などの芳香族基であり、 R⁴は炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン 基、アルキニレン基、フェニレン基やナフチレン基など の二価の芳香族基、芳香族基が直接または架橋員により 炭素数1から30のアルキレン基、アルケニレン基、ア ルキニレン基、芳香族基と連結した基であり、これらの

基はハロゲン原子、水酸基、アミノ基、カルボキシル 20 基、エーテル基などの置換基を含んでいてもよい。nは 0または4以下の正の整数である。) で表される繰り返 し単位を含むアセチレン結合を有するケイ素系ポリマー の製造方法である。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の製造方法の特徴は、要約 すると、反応式(5)(化9)

[0013]

で表されるように、R -- a - S i H a で表されるシリル化 合物とR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物を金属 水素化物の存在下で脱水素反応させることにより、一般 式(1)で表されるシリルアセチレン化合物が製造でき※

※るととにある。

【0014】また、反応式(6)(化10)

[0015]

で表されるように、SiH.とR¹-C≡CHで表される エチニル化合物を金属水素化物の存在下でピス(2 - メ 40 【0016】また、反応式(7)(化11) トキシエチル) エーテルおよび/または1,2ービス (2-メトキシエトキシ) エタンを溶媒として脱水素反 応させることにより、一般式(2)で表されるシリルア★

★セチレン類が製造できることにある。

[0017]

【化11】

$$R^2-SiH_2-R^3$$
 + $HC \equiv C - \left(R^4\right)_n C \equiv CH - \frac{-2H_2}{-2H_2}$ R^2 $-C \equiv C - \left(R^4\right)_n C \equiv C - \frac{1}{Si}$ (7)

で表されるように、 $R^4 - S \ i \ H_2 - R^4$ で表されるヒド 50 ロシリル化合物と一般式(3)で表されるジエチニル化

合物を金属水素化物の存在下で反応させることにより一 般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン結 合を有するケイ素系ポリマーが製造できることにある。

[0018] 反応式(5)、反応式(6)、反応式 (7)で使用し得る金属水素化物触媒としては金属水素 化合物、複合金属水素化合物およびこれらの水素の一部 がアルキル基、アリル基、アルコキシ基、シアノ基など で置き換わった化合物などが挙げられる。金属水素化合 物としては、LiH、NaH、KHなどの 1 族典型元素 水素化物、CaH,などの2族典型元素水素化合物、B H,、A1H,などの13族典型元素水素化合物などが挙 げられる。また、複合金属水素化合物としてはLiBH ., NaBH., KBH., Mg (BH.) ;, Ca (B H₄), Ba (BH₄), Sr (BH₄), Zn (BH *) z, Al (BH*) 3, LiAlH*, NaAlH*, (CH₃) 4NBH₄、(n-C₄H₃) 4NBH₄などが挙 げられる。また、水素の一部が他の置換基で置き換わっ た化合物としては、LiBH(C,H,),、LiBH (s-C,H,), KBH (C,H,), NaBH (OCH,), NaBH (OC,H,), NaBH (OCOC H,), NaBH, CN, (i-C, H,), AlH, (i -C, H,), AlH, LiAlH, (OC, H,), Li $AlH(OC_1H_1)_1$, LiAlH(OC(C₁H₁)₁) , LiAlH (OC (CH₁),), NaAlH, (O CH, CH, CH,) 2. NaAlH, (C, H,), SnH (n-C,H,),、SnH(C,H,),などが挙げられ る。これらの金属水素化物は単独であるいは二種以上を 混合して使用することができる。

【0019】R.----SiH.で表されるシリル化合物と R¹-C≡CHで表されるエチニル化合物を金属水素化 物の存在下で脱水素反応させることにより、一般式

(1) で表されるシリルアセチレン化合物を製造する方 法を説明する。原料のR...。--SiH.で表されるシリル 化合物としては、具体的にはメチルシラン、ジメチルシ **ラン、トリメチルシラン、エチルシラン、ジエチルシラ** ン、トリエチルシラン、フェニルシラン、ジフェニルシ ラン、トリフェニルシラン、ヘキシルシラン、ピニルシ ラン、アリルシラン、エチニルシラン、2 - プロピニル シラン、ベンゾイルシラン、トリフルオロメチルシラ ン、(3,3,3-トリフルオロプロピル)シラン、4-シリルトルエン、4 - シリルスチレン、4 - シリルー α , α , α – トリフルオロトルエン、メトキシシラン、 ジメトキシラン、トリメトキシシラン、エトキシシラ ン、ジエトキシシラン、トリエトキシシランなどが挙げ られる.

【0020】また、原料のR¹-C≡CHで表されるエ チニル化合物としては、具体的には、アセチレン、プロ ビン、1ープチン、1ーヘキシン、ピニルアセチレン、 ジアセチレン、フェニルアセチレン、エチニルシクロへ キサン、4-エチニルトルエン、4-エチニルアニリ

ン、3-エチニルアニリンなどが挙げられる。

【0021】木発明で得られる一般式(1)で表される シリルアセチレン化合物としては、具体的にはメチルシ リルアセチレン、ジメチルシリルアセチレン、トリメチ ルシリルアセチレン、エチルシリルアセチレン、ジエチ ルシリルアセチレン、トリエチルシリルアセチレン、フ ェニルシリルアセチレン、ジフェニルシリルアセチレ ン、トリフェニルシリルアセチレン、ヘキシルシリルア セチレン、ピニル(エチニル)シラン、アリル(エチニ 10 ル)シラン、ジエチニルシラン、2-プロビニル (エチ ニル) シラン、ベンゾイル (エチニル) シラン、トリフ ルオロメチル (エチニル) シラン、(3,3,3ートリフ ルオロプロピル)(エチニル)シラン、4 -- (エチニル シリル)トルエン、4-(エチニルシリル)スチレン、 4- (エチニルシリル) -α, α, α-トリフルオロト ルエン、メトキシシリルアセチレン、ジメトキシシリル アセチレン、トリメトキシシリルアセチレン、エトキシ シリルアセチレン、ジエトキシシリルアセチレン、トリ エトキシシリルアセチレン、メチルシリルー 1 ープロピ 20 ン、ジメチルシリルー1-プロピン、トリメチルシリル **-1-プロピン、エチルシリル-1-プロピン、ジエチ** ルシリルー1ープロピン、トリエチルシリルー1-プロ ピン、フェニルシリルー1-プロピン、ジフェニルシリ ルー1ープロピン、トリフェニルシリルー1ープロピ ン、ヘキシルシリルー1-プロピン、メチルシリルー1 - プチン、ジメチルシリル・1 - ブチン、トリメチルシ リルー 1 ープチン、エチルシリルー 1 ープチン、ジエチ ルシリルー1-プチン、トリエチルシリル-1-プチ ン、フェニルシリルー1ープチン、ジフェニルシリルー **1-プチン、トリフェニルシリル-1-ブチン、ヘキシ** ルシリル-1-プチン、メチルシリル-1-ヘキシン、 ジメチルシリルー1-ヘキシン、トリメチルシリル-1 ーヘキシン、エチルシリルー1ーヘキシン、ジエチルシ リルー1 -ヘキシン、トリエチルシリルー1 -ヘキシ ン、フェニルシリル-1-ヘキシン、ジフェニルシリル -1-ヘキシン、トリフェニルシリル-1-ヘキシン、 ヘキシルシリルー1-ヘキシン、メチルシリルー2-ブ **デンー1ーイン、ジメチルシリルー2ープテンー1ーイ** ン、トリメチルシリルー2-ブテン-1-イン、エチル 40 シリルー2ープテン-1-イン、ジエチルシリルー2-ブテンー1-イン、トリエチルシリルー2-ブテン-1 **ーイン、フェニルシリルー2-プテン-1-イン、ジフ** ェニルシリルー2ープテンー1ーイン、トリフェニルシ リルー2-プテンー1-イン、ヘキシルシリルー2-プ テンー1-イン、メチルシリル-1,3-ブタジイン、 ジメチルシリルー1 ,3 ーブタジイン、トリメチルシリ ルー1,3-ブタジイン、エチルシリルー1,3-ブタジ イン、ジエチルシリル…1,3 …ブタジイン、トリエチ ルシリルー1,3ープタジイン、フェニルシリルー1,3 50 ープタジイン、ジフェニルシリルー1,3ープタジイ

ン、トリフェニルシリルー 1 , 3 ープタジイン、ヘキシ ルシリルー1,3ープタジイン、メチルシリル(フェニ ル) アセチレン、ビス(フェニルエチニル)メチルシラ ン、トリ (フェニルエチニル) メチルシラン、ジメチル シリル (フェニル) アセチレン、ピス (フェニルエチニ ル) ジメチルシラン、トリメチルシリル(フェニル)ア セチレン、エチルシリル (フェニル) アセチレン、ビス (フェニルエチニル) エチルシラン、トリ(フェニルエ チニル) エチルシラン、ジエチルシリル(フェニル)ア セチレン、ビス(フェニルエチニル)ジエチルシラン、 トリエチルシリル (フェニル) アセチレン、フェニルシ リル (フェニル) アセチレン、ピス (フェニルエチニ ル) フェニルシラン、トリ(フェニルエチニル)フェニ ルシラン、ジフェニルシリル (フェニル) アセチレン、 ピス (フェニルエチニル) ジフェニルシラン、トリフェ ニルシリル (フェニル) アセチレン、ヘキシルシリル (フェニル) アセチレン、ビス (フェニルエチニル) へ キシルシラン、トリ (フェニルエチニル) ヘキシルシラ ン、ビニル(フェニルエチニル)シラン、アリル(フェ ニルエチニル) シラン、フェニルエチニル(エチニル) シラン、2ープロピニル(フェニルエチニル)シラン、 ベンゾイル (フェニルエチニル) シラン、トリフルオロ メチル (フェニルエチニル) シラン、(3,3,3-トリ フルオロプロピル)(フェニルエチニル)シラン、4 --(フェニルエチニルシリル) トルエン、4 - (フェニル エチニルシリル)スチレン、4 -- (フェニルエチニルシ リル) - α, α, α-トリフルオロトルエン、メトキシ シリル (フェニル) アセチレン、ジメトキシシリル(フ ェニル) アセチレン、トリメトキシシリル(フェニル) アセチレン、エトキシシリル (フェニル) アセチレン、 ジエトキシシリル (フェニル) アセチレン、トリエトキ シシリル (フェニル) アセチレン、メチルシリルエチニ ・ルシクロヘキサン、ジメチルシリルエチニルシクロヘキ サン、トリメチルシリルエチニルシクロヘキサン、フェ ニルシリルエチニルシクロヘキサン、ジフェニルシリル エチニルシクロヘキサン、トリフェニルシリルエチニル シクロヘキサン、ヘキシルシリルエチニルシクロヘキサ ン、4-(メチルシリルエチニル)トルエン、4-(ジ メチルシリルエチニル)トルエン、4-(トリメチルシ ル) トルエン、4-(ジフェニルシリルエチニル)トル エン、4 - (トリフェニルシリルエチニル)トルエン、 4-(メチルシリルエチニル) アニリン、4-(ジメチ ルシリルエチニル)アニリン、4 …(トリメチルシリル エチニル) アニリン、4-(フェニルシリルエチニル) アニリン、ピス(4-アミノフェニルエチニル)(フェ ニル) シラン、ピス (4-アミノフェニルエチニル) ジ フェニルシラン、4 …(ジフェニルシリルエチニル)ア ニリン、4-(トリフェニルシリルエチニル)アニリ ン、3-(メチルシリルエチニル)アニリン、3-(ジ 50 mmol に対して $0.1\sim40\,\mathrm{m}\,l$ が好ましい。また、

メチルシリルエチニル) アニリン、3-(トリメチルシ リルエチニル)アニリン、3-(フェニルシリルエチニ ル) アニリン、ビス(3-アミノフェニルエチニル) (フェニル) シラン、3 - (ジフェニルシリルエチニ ル) アニリン、ピス(3-アミノフェニルエチニル)ジ フェニルシラン、3-(トリフェニルシリルエチニル) アニリンなどが挙げられる。

【0022】反応装置は原料を供給する部分、反応容器 内部の攪拌装置、反応容器の温度を制御する部分などか **ちなる。本反応は、無溶媒もしくは溶媒中で反応させる** ことができる。容器内に原料のR → □ ーS i H □ で表され るシリル化合物とR¹−C≡CHで表されるエチニル化 合物および触媒である金属水素化物、さらに必要に応じ て溶媒を仕込む。これらの容器への仕込の順序は特に限 定するものではない。反応溶液を所定の温度に制御しつ つ、攪拌しながら所定の時間反応させる。所定の反応時 間後、蒸留またはカラム分離などの方法により、反応液 より生成物を分離精製する。

20 合物とR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物の仕込 みの比率は特に限定するものではないが、好ましくはエ チニル化合物100mmoに対し1mmolから100 ○○mmolである。触媒である金属水素化物は単独で あるいは二種以上を混合して使用することができる。触 媒使用量はR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物1 00mmolに対し0.0001mmolから200m molである。

合物またはR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物が 30 気体の場合にはそのままあるいは高純度窒素、高純度へ リウム、高純度アルゴンなどの不活性ガスと混合して使 用できる。原料のシリル化合物およびエチニル化合物が ともに液体または固体の場合には反応容器内は高純度窒 素あるいは高純度ヘリウム、高純度アルゴンなどの不活 性ガスで置換することが望ましい。シリル化合物または エチニル化合物の沸点が反応温度以下の場合は不活性ガ スの圧入などにより反応圧力を1~250kg/cm゚ Gに加圧し、原料の沸点を反応温度以上にすることが好 ましい。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレ **リルエチニル)トルエン、4 -- (フェニルシリルエチニ 40 ン、エチルベンゼン、メシチレンのような芳香族系炭化** 水素溶媒や、ジエチルエーテル、nープチルエーテル、 アニソール、ジフェニルエーテル、テトラヒドロフラ ン、ジオキサン、ビス(2-メトキシエチル)エーテ ル、1、2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタンのよ うなエーテル系溶媒や、ジクロロメタン、クロロホルム のような含ハロゲン溶媒や、N-メチルピロリドン、ジ メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのような有 機極性溶媒及びこれらの混合溶媒が使用できる。溶媒の 量は原料のR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物1

溶媒に含まれる水分が触媒の活性を低下させる場合があるので、溶媒は予め脱水乾燥したものを用いるのが好ましい。

【0025】反応温度は0~200℃、より好ましくは20~150℃である。反応圧力は常圧、加圧のいづれでもかまわないが、原料が常圧で気体または反応温度が原料の常圧における沸点よりも高い場合には、耐圧の反応容器を用いて加圧(0~250kg/cm²・G)し、反応温度における原料の状態を液体にすることが望ましい。反応時間は反応温度などにより異なるが1~2 1000時間が適切である。

【0026】生成物の精製は、反応液に何も処理を施さ ない状態で行ってもかまわないが、反応液を水中に分散 させることにより触媒を分解分離した後で行うことが好 ましい。触媒を分解分離する水は酸性、中性のいずれで もかまわないがHF、HCI、HBr、HI、H,S O4, HNO3, H2CO3, H3PO4, HClO2, H 、S、H、SO、、H、S、O、などの無機酸またはHCOO H、CH,COOH、C。H,COOH、 蓚酸などの有機 酸によりpH0~pH5の酸性状態であることが好まし い。水の量は触媒1mmo1に対し0.4m1~400 mlである。無溶媒または水に対する溶解度が5wt% 以上の反応溶媒を使用した場合は分散させる前に脱水乾 燥したベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭 化水素溶媒を原料のR¹-C≡CHで表されるエチニル 化合物 l m m o l に対し0. l m l ~ 4 0 m l 加えてお くことが好ましい。

【0027】次に、SiH、とR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物を金属水素化物の存在下でビス(2-メトキシエチル)エーテルおよび/または1、2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタンを溶媒として脱水素反応させることにより、一般式(2)で表されるシリルアセチレン類を製造する方法について説明する。原料のR¹-C≡CHで表されるエチニル化合物としては、シリルアセチレン化合物の原料であるエチニル化合物が使用できる。

シリルエチニルアニリン、ピス(3-アミノフェニルエ チニル) シランなどが挙げられる。

12

【0029】反応装置は耐圧の反応容器、原料を供給する部分、反応容器内部の摂拌装置、反応容器の温度を制御する部分などからなる。容器内に原料のSiH、とR'-C≡CHで表されるエチニル化合物および触媒である金属水素化物、さらに溶媒であるビス(2-メトキシエチル)エーテルおよび/または1,2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタンを仕込む。これらの容器への仕込の順序は特に限定するものではない。反応溶液を所定の温度に制御しつつ、攪拌しながら所定の時間反応させる。所定の反応時間後、未反応のSiH、および生成した水素ガスを除去し、蒸留またはカラム分離などの方法により、反応液より生成物のシリルアセチレン類を精製する。精製方法としては減圧蒸留またはカラム分離などの方法が使用できる。

[0030] SiH.はそのままあるいは高純度窒素、高純度ヘリウム、高純度アルゴンなどの不活性ガスと混合して使用できる。触媒の金属水素化物は単独であるいは二種以上を混合して使用することができる。触媒使用量は原料のエチニル化合物100mmolに対し0.000mmolから200mmolである。溶媒のビス(2-メトキシエチル)エーテルおよび/または1,2ービス(2-メトキシエトキシ)エタンの量は原料のエチニル化合物1mmolに対して0.1~20mlが好ましい。また、ビス(2-メトキシエトキシ)エタンに含まれる水分が触媒の活性を低下させる場合があるので、ビス(2-メトキシエチル)エーテルまたは1,2ービス(2-メトキシエチル)エーテルまたは1,2ービス(2-メトキシエチル)エーテルまたは1,2ービス(2-メトキシエチル)エーテルまたは1,2ービス(2-メトキシエチル)エーテルまたは1,2ービス(2-メトキシエトキシ)エタンは予め脱水乾燥したものを用いるのが好ましい。

【0031】反応温度は0~200℃、より好ましくは20~150℃である。反応圧力は1~250kg/cm²・Gである。反応時間は反応温度、触媒使用量などにより異なるが1~200時間が適切である。

【0032】生成物の精製は、反応液に何も処理を施さない状態で行ってもかまわないが、反応液を水中に分散させることにより触媒を分解分離した後で行うことが好ましい。触媒を分解分離する水は酸性、中性のいずれでもかまわないがHF、HC1、HBF、HI、H₂S〇4、HNO3、H₂S〇3、H₂S〇3などの無機酸またはHCOOH、CH,COOH、С。H,COOH、蓚酸などの有機酸によりpH0~pH5の酸性状態であることが好ましい。水の量は触媒1mmo1に対し0、4m1~400mlである。反応液は分散させる前に脱水乾燥したベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭化水素溶媒を原料のR¹・C≡CHで表されるエチニル化合物1mmo1に対し0、1m1~40m1加えておくことが好ましい。

【0033】次に、R'-SiH,-R'で表されるヒド ロシリル化合物と一般式(3)で表されるジエチニル化 合物を金属水紫化物の存在下で反応させることにより---般式(4)で表される繰り返し単位を含むアセチレン結 合を有するケイ索系ポリマーを製造する方法について説 明する。本発明におけるR'-SiH,-R'で表される ヒドロシリル化合物としてはメチルシラン、ジメチルシ **ラン、エチルシラン、ジエチルシラン、フェニルシラ** ン、ジフェニルシラン、ヘキシルシラン、ピニルシラ ン、アリルシラン、エチニルシラン、1-シリル-2- 10 プロピン、ベンゾイルシラン、トリフルオロメチルシラ ン、1-シリルー3,3,3-トリフルオロプロパン、4 -シリルトルエン、4 - シリルスチレン、4 - シリルエ チニルトルエン、4-シリル-α,α,α-トリフルオ ロトルエン、メトキシシラン、ジメトキシシランシラ ン、エトキシシラン、ジエトキシシランなどが挙げられ る。

【0034】本発明で使用する一般式(3)で表される ジエチニル化合物としては、具体的にはジアセチレン、 m-ジェチニルベンゼン、p-ジェチニルベンゼン、o 20 -ジェチニルベンゼン、3,5-ジェチニルトルエン、 2,7-ジェチニルナフタレン、5,10-ジエチニルア ントラセン、4,4'ージエチニルピフェニル、ピス(4 ーエチニルフェニル) メタン、2,2-ビス (p-エチ ニルフェニル) プロパン、2,2-ビス (p-エチニル *

*フェニル)トリフルオロプロパン、ビス(4 -エチニル フェニル) エーテル、2,2-ビス (p-エチニルフェ ニル) スルフォン、2,6 - ジエチニルビリジン、2,5 -ジェチニルチオフェン、化学式(8)(化12) [0035]

14

【化12】

、化学式(9)(化13)

[0036]

[(£13]

、化学式(10)(化14)

[0037]

[化14]

、化学式(11)(化15) [0038] 【化15】

HCEC
$$CF_3$$
 N $CECH$ (11)

. 化学式(12)(化16) [0039]

HC
$$\equiv$$
 C \downarrow C \downarrow

である。

【0040】本発明で得られるアセチレン結合を有する ケイ素系ポリマーは、具体的には繰り返し単位が化学式 (13)(化17)

[0041]

[(117)

、化学式 (14) (化18)

[0042]

【化18】

※【化16】

、化学式(15)(化19)

C≡C-C≡C-

[0043]

【化19】

(14)

、シリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン (化学式(18))(化20)

[0044]

50 [化20]

20

、シリレンエチニレン-1,4-フェニレンエチニレン、 シリレンエチニレン-1,2-フェニレンエチニレン、フェニルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン(化学式(17))(化21)

[0045]

【化21】

、フェニルシリレンエチニレン-1,4-フェニレンエチニレン、フェニルシリレンエチニレン-1,2-フェニレンエチニレン、メチルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチニレン(化学式(18))(化2)

[0046]

[(t22]

、ジフェニルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエ チニレン、メチルシリレンエチニレン-1,4-フェニレ ンエチニレン、メチルシリレンエチニレン-1,2-フェ ニレンエチニレン、化学式(19)(化23)

[0047]

[化23]

$$\begin{array}{c}
C \equiv C - \\
-Si - C \equiv C - \\
\end{array}$$
(19)

、ジメチルシリレンエチニレン-1,3-フェニレンエチ ニレン、化学式(20)(化24)

[0048]

[化24]

、化学式 (21) (化25)

[0049]

【化25】

、化学式(22)(化26)

、化学式(23)(化27)

[0051]

[(t27]

、化学式(24)(化28)

[0052]

[化28]

、化学式(25)(化29)

[0053]

[{£29]

、化学式(26)(化30)

[0054]

【化30】

、化学式 (27) (化31)

[0055]

40 【作31】

、化学式(28)(化32)

[0056]

[化32]

50

、化学式(29)(化33)

[0057]

[化33]

、化学式 (30) (化34)

[0058]

【化34】

、化学式(31)(化35)

[0059]

[化35]

、化学式(32)(化36)

[0060]

[1t36]

、化学式(33)(化37)

[0061]

[化37]

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
-SI - C \equiv C - C - C - C - C = C - C
\end{array}$$
(33)

、化学式(34)(化38)

[0062]

(化38)

、化学式(35)(化39)

[0063]

[化39]

、化学式(36)(化40)

[0064]

[{£40]

20 、化学式(37)(化41)

[0065]

【化41】

、化学式(38)(化42)

[0066]

30 【化42】

、化学式(39)(化43)

[0067]

[{{\psi}43}

、化学式(40)(化44)

[0068]

[{{44}}]

40

、化学式(41)(化45)

[0069]

50 【化45】

$$CH_3$$

$$C \equiv C$$

$$C = C$$

$$CH_3$$

$$C = C$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

、化学式(42)(化46)

[0070]

[化46]

、化学式(43)(化47)

[0071]

[{k47}

$$\begin{array}{c}
 \text{n-} C_8H_{11} \\
 -\text{SI-}C \equiv C
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{C} \equiv C - \\
 \text{CH}_3
\end{array}$$
(43)

、化学式(44)(化48)

[0072]

【化48】

、化学式(48)(化52)

[0076]

$$\begin{array}{c} \\ -\text{Si-C} \equiv \text{C} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CF}_3 \\ \text{CF}_3 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{N-C} \equiv \text{C} \\ \text{(4B)} \end{array}$$

などである。

【0077】反応装置は原料を供給する部分、反応容器 内部の攪拌装置、反応容器の温度を制御する部分などか ちなる。本反応は、無溶媒もしくは溶媒中で反応させる ことができる。容器内に原料のR'-SiH,-R'で表 されるヒドロシリル化合物と一般式(3)で表されるジ エチニル化合物および触媒である金属水素化物、さらに 必要に応じて溶媒を仕込む。これらの容器への仕込の順 序は特に限定するものではない。反応溶液を所定の温度 に制御しつつ、攪拌しながら所定の時間反応させる。所 定の反応時間後、蒸留による原料および溶媒の除去、カ 50 し0.0001mmolから200mmolである。

ラム分離もしくはポリマーの貧溶媒中に反応液を分散さ せるなどの方法により、反応液よりポリマーを分離精製 する。

【0078】原料のR'-SiH,-R'で表されるヒド ロシリル化合物と一般式(3)で表されるジエチニル化 合物の比率は特に限定するものではないが好ましくはジ エチニル化合物 100mmol に対し10mmolから 1000mmolである。触媒である金属水素化物は単 独であるいは二種以上を混合して使用することができ る。触媒使用量はジエチニル化合物100mmolに対

NHCO-

、化学式(45)(化49)

[0073]

[(149]

、化学式(46)(化50)

[0074]

【化50】。

、化学式(47)(化51)

[0075]

【化51】

※【化52】

【0078】原料のR'-SiH,-R'で表されるヒド ロシリル化合物または一般式(3)で表されるジエチニ ル化合物が気体の場合にはそのままあるいは高純度窒 素、高純度ヘリウム、高純度アルゴンなどのなどの不活 性ガスと混合して使用できる。原料のヒドロシリル化合 物およびジエチニル化合物がともに液体または固体の場 合には反応容器内は高純度窒素あるいは高純度ヘリウ ム、髙純度アルゴンなどの不活性ガスで置換することが 望ましい。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレ ン、エチルベンゼン、メシチレンのような芳香族炭化水 10 紫系溶媒や、ジエチルエーテル、n - ブチルエーテル、 アニソール、ジフェニルエーテル、テトラヒドロフラ ン、ジオキサン、ピス(2 - メトキシエチル)エーテ ル、1、2 - ピス(2 - メトキシエトキシ)エタンのよ うなエーテル系溶媒や、ジクロロメタン、クロロホルム のような含ハロゲン溶媒や、N-メチルピロリドン、ジ メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのような有 機極性溶媒及びこれらの混合溶媒が使用できる。溶媒の 量は原料のジエチニル化合物 1 mm o 1 に対して 0. 1 ~40mlが好ましい。また、溶媒に含まれる水分が触 20 媒の活性を低下させる場合があるので、溶媒は予め脱水 乾燥したものを用いるのが好ましい。

【0080】反応温度は0~200℃、より好ましくは20~150℃である。反応圧力は常圧、加圧のいづれでもかまわないが、原料が気体または反応温度が原料や溶媒の沸点よりも高い場合には耐圧の反応容器を用いて加圧(0~250kg/cm²・G)反応を行うことが望ましい。反応時間は反応温度などにより異なるが1~200時間が適切である。

【0081】生成物の精製は、反応液に何も処理を施さ ない状態で行ってもかまわないが、反応液を水中に分散 させることにより触媒を分解分離した後で行うことが好 ましい。触媒を分解分離する水は酸性、中性のいずれで もかまわないがHF、HC1、HBr、HI、H,S O4, HNO3, H2CO3, H3PO4, HClO2, H , S、H, SO, 、H, S, O, などの無機酸またはHCOO H、CH, COOH、C, H, COOH、蓚酸などの有機 酸によりpH0~pH5の酸性状態であることが好まし い。水の蟹は触媒 1 mm o 1 に対し0. 4 m 1 ~ 4 0 0 mlである。無溶媒または水に対する溶解度が5wt% 以上の反応溶媒を使用した場合は分散させる前に脱水乾 燥したベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系炭 化水素溶媒を原料の一般式(3)で表されるジエチニル 化合物1mmolに対し0.1m1~40m1加えてお くことが好ましい。

【0082】ポリマーを析出分離する場合に使用できる 貧溶媒にはペンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタンな どの脂肪族炭化水素やメタノール、エタノール、プロパ ノールなどの脂肪族アルコールが挙げられる。 貧溶媒の 使用量は原料のジエチニル化合物 1 mm o 1 に対して 0. 1~200ml、より好ましくは1~50mlである。

[0083]

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例によって説明する。

実施例1

100mlのガラス製容器の内部に磁気攪拌子を設置し、容器内を高純度窒素ガスで置換した。続いて容器内に原料のフェニルシラン5.7g(53mmol)、フェニルアセチレン5.4g(53mmol)、溶媒のビス(2-メトキシエチル)エーテル10ml、触媒のLiA1H、0.103g(2.7mmol)を仕込み、120℃で20時間攪拌を行った。反応後、反応液をGC(ガスクロマトグラフィー)で分析した。生成物としてフェニルエチニル(フェニル)シラン(収率42%)およびピス(フェニルエチニル)(フェニル)シラン(収率9%)が得られた。また、反応率はフェニルシラン53%、フェニルアセチレン56%であった。との結果より、金属水素化物触媒により簡便にシリルアセチレン化合物が製造できることが示された。

[0084] 実施例2

反応容器に70mlの耐圧性密封容器を用い、その他の 条件は実施例1と同一にして反応を行った。結果を表1 に示す

[0085] 実施例3

溶媒にテトラヒドロフラン10mlを用い、その他の条件は実施例2と同一にして反応を行った。結果を表しに示す。

[0086] 実施例4

) 反応温度を80℃とし、その他の条件は実施例3と同一 にして反応を行った。結果を表1に示す。

【0087】実施例5

触媒としてNaAlH、0.136g(2.5mmol) を用い、その他の条件は実施例1と同一にして反応を行った。結果を表1に示す。

[0088] 実施例6

触媒としてLiBH.0.066g(3.0mmo 1)、その他の条件は実施例1と同一にして反応を行った。結果を表1に示す。

40 【0089】比較例1

70m1の耐圧ステンレス容器に1-ヘキシン1.64 g(20mmo1)、溶媒のテトラヒドロフラン5m 1、触媒のLiAlH。0.038g(1mmo1)および原料のSiH。ガス30kg/cm²G(80mmo1)を圧入し、120℃で20時間攪拌を行った。反応後、未反応SiH。を除去し、反応液をGCで分析した。生成物として1-シリル-1-ヘキシン4.8mmo1(収率24%)、ピス(1-ヘキシニル)シラン1.4mmo1(収率7%)が得られた。

50 【0090】実施例7

溶媒としてピス(2-メトキシエチル)エーテル5ml を用い、その他の条件は比較例1と同一にして反応を行 った。GCで分析した結果、生成物として1-シリルー 1-ヘキシン6.2mmol(収率31%)、ピス(1 -ヘキシニル) シラン2. 2mmol (収率11%) が 得られた。実施例7と比較例1の結果の比較より本発明 の優位性は明かである。

【0091】実施例8

70mlの耐圧ステンレス容器内にフェニルシラン5. 8g (53mmol)、m-ジエチニルベンゼン6.7 10 1, 2155、3067、3290。 g (53mmol)、溶媒としてテトラヒドロフラン1 Om 1、触媒としてLiA1H。O. 100g(2.6) mm o 1)を密封し、120℃で20時間攪拌を行っ た。反応液をGCで分析したところフェニルシランの反 応率は76%、m-ジェチニルベンゼンの反応率は92 %であった。 反応液に脱水トルエン20m1を加え、 1規定塩酸水溶液20m1中に分散させた。 有機相を 1規定塩酸水溶液5m1で洗浄後、純水5m1づつで水 相のpHが6になるまで洗浄した。CaSO、により脱 水を行った後、5mmHgで52時間真空乾燥をおこな 20 い8.4gのポリマーを得た(収率87%)。GPC (ゲルバーミゼーションクロマトグラフィー) によるポ リスチレン換算重量平均分子量は約2600であった。 さらに分取用GPCカラムを用いて分子量で3600か ち1600の成分を分取しNMR、IR測定を行った。 図1、図2、図3にポリマーの'H、''C、''Si-N MRスペクトル、図4にIRスペクトルを示す。

* [0092] 1 H-NMR(ppm,CDCl₃) 3.1.(C=C- \underline{H}), 4.7(S i<u>H</u>,)、5.1(Si<u>H</u>)、7.3~7.9(Ph-H)。

24

¹³ C-NMR(ppm,CDCl₃) 78.1(-C \equiv CH), 82.4(- \subseteq CH), 8 6.5(Si-C≡C--)、107.2(Si-C≡C--)、122.7(Ph)、128.3~ 135.9(Ph).

**Si-NMR(ppm,CDCl₃) -59.8(-<u>Si</u>H2-Ph)、-63.5(><u>Si</u>H-P h), -69.4(>Si<).

433、476、492、602、696、736、 IR (cm⁻¹) 796, 844, 948, 1114, 1166, 1264, 1429, 1474, 159

【0093】NMR、IRスペクトルからとのポリマー は特開平5-345825の実施例1で合成したポリマ ーと同じポリ(フェニルシリレンエチニレン-1,3-フ ェニレンエチニレン) であることは明かである。この結 果より、金属水素化物触媒により簡便にアセチレン結合 を有するケイ素系ポリマーが合成できることが示され

【0094】実施例9

溶媒にピス (2-メトキシエチル) エーテル 10mlを 用い、その他の条件は実施例8と同一にして反応を行っ た。結果を表2に示す。

【0095】実施例10

反応容器として100m1のガラス製容器を用い、その 他の条件は実施例9と同一にして常圧で反応をおこなっ た。結果を表2に示す。

[0096]

【表1】

没!								
実施	数数 (mmol)	溶媒	反応 条件	反反 フェニル シラン	本(%) 7x二// 7tfby	生后 PESI ¹⁾	t物収率 ⁹ BPESI ²¹	(%) その他
1	LiAIH ₄ 2.7	diglyme	常圧 120℃	53	56	42	9	2
2	LiAIH. 2.7	diglyme	密封 ⁴⁾ 120℃	38	66	28	4	7
3	LiAIH. 2.6	THF	務封 ⁴⁾ 120℃	54	81	18	1	15
4	LIAIII ₄ 2.6	THF	密封 ⁴⁾ 80℃	31	38	20	2	5
5	NaAlH ₄ 2.5	digiyme	捻压 120℃	44	45	31	5	1
6	LIBH ₄ 3.0	diglyme	常圧 120°C	44	67	18	0.5	11

*仕込み世 ; フュニルシラン:53mmol, フュニルアセチレン:53mmol

1) PESI : フュニルエチニル(フュニル)シラン, 2) BPSI : ピス(フュニルエチニル)(フュニル)シラン

3) 生成物収率; フュニルシランに対する値、4) ステンレス容器に密封して反応

【表2】

[0097]

25 表**2**

72. 4							
実施 例	触媒 (mmol)	溶媒	反応 条件	反応率(%) フェニル ジエチニル シラン ベンゼン		生成ポリマー Mw 収率 ¹⁾ (%)	
8	LIAIH ₄ 2.6	THF	常 <u>E</u> 120℃	76	92	2602	67
9	LiAlH ₄ 2.6	diglyma	密封 ²⁾ 120℃	45	70	1147	47
10	LiAIH ₄	diglyme	密封 ²⁾	51	52	682	46

*仕込み厳;フュニカシラン:53mmol,フュニルアセチレン:53mmol

- 1) フォニルクランとm-ジエテニルベンピンの合計重量に対するポリマー重量
- 2) ステンレス容器に密封して反応

[0098]

【発明の効果】金属水素化物を触媒とすることにより、シリル化合物とエチニル化合物からシリルアセチレン化合物を、ヒドロシリル化合物とジエチニル化合物よりケイ素系ポリマーを簡便に製造することができた。また、溶媒にピス(2ーメトキシエチル)エーテルまたは1.2ーピス(2ーメトキシエトキシ)エタンを選択することにより、SiH、とエチニル化合物から金属水素化物触媒によりシリルアセチレン類を高収率で製造することができた。

*【図面の簡単な説明】

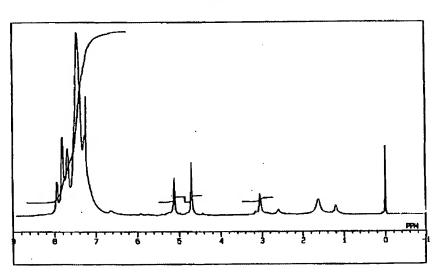
【図1】実施例8で合成されたポリマーの¹ H - NMR スペクトルである。

【図2】実施例8で合成されたポリマーの¹³C-NMR スペクトルである。

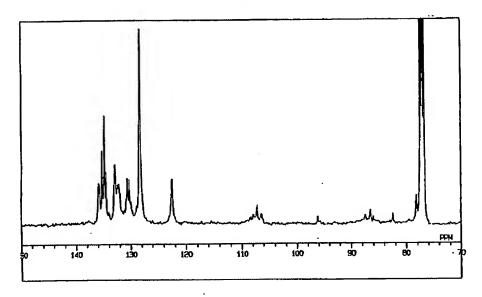
【図3】実施例8で合成されたポリマーの²⁸ S i -- NM Rスペクトルである。

20 【図4】実施例8で合成されたポリマーのIRスペクトルである。

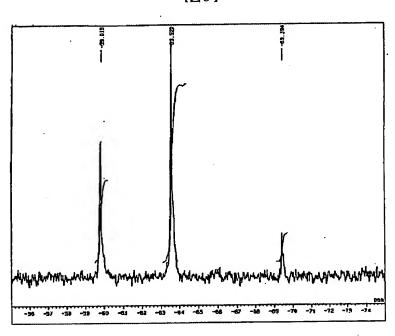
[図1]



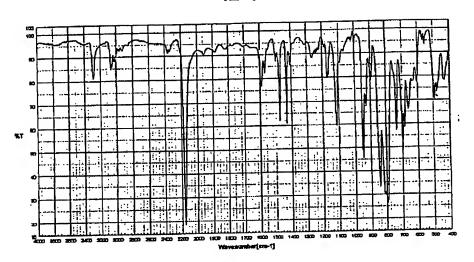
[図2]



【図3】







フロントページの続き

(72)発明者 藤掛 史朗

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

井

(72)発明者 伊藤 正義

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内